

SONY[®]

2SC633SP 2SC634SP

構造 NPN シリコン エピタキシャル プレーナ形 トランジスタ

(2) 用途 低周波増幅, 高周波増幅, 発振, スイッチング, 低雑音増幅

(3) 絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

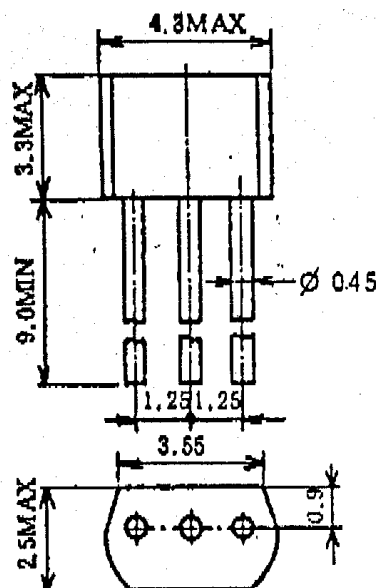
	2SC633SP	2SC634SP
コレクタ・ベース間電圧	V_{CBO} 26 V	52 V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO} 26 V	52 V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO} 6 V	
コレクタ電流	I_{C} 200 mA	
ベース電流	I_{B} 50 mA	
コレクタ損失	P_{O} 300 mW	
ジャンクション温度	T_{j} $+125^\circ\text{C}$	
保存温度	T_{stg} $-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	
熱抵抗	$\theta_{\text{j-e}}$ 300 $^\circ\text{C/W}$	

(4) 外形

Dimension in mm

Terminal Connection

- ① : Emitter
- ② : Collector
- ③ : Base



(7) 電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

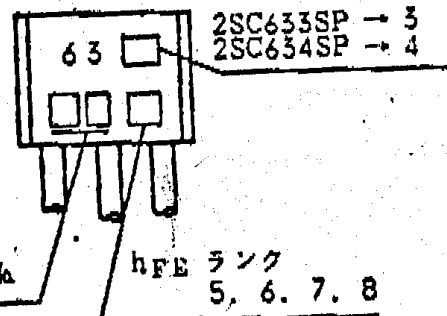
項 目	記号	検 査 条 件	最小値	標準値	最大値	単 位
コレクタ・エミッタ間 電 圧	V_{CE0}	$I_C = 2\text{mA}$	2SC633SP	2 6		V
			2SC634SP	5 2		
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 25\text{V}, I_E = 0$			0.15	μA
エミッタ遮断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = 6\text{V}, I_C = 0$			0.8	μA
直 流 電 流 増 巾 率	h_{FE1}	$V_{CE} = 3\text{V}, I_C = 1\text{mA}$	2SC633SP	2 1 6	660	
			2SC634SP	8 7	660	
"	h_{FE2}	$V_{CE} = 1\text{V}, I_C = 200\text{mA}$		4 5		
コレクタ・エミッタ間 飽和電圧	V_{CE} (SAT)	$I_C = 50\text{mA}, I_E = 10\text{mA}$			0.2	V
エミッタ・ベース間 飽和電圧	V_{BE} (SAT)	$I_C = 50\text{mA}, I_E = 10\text{mA}$			1.2	V
トランジション 周波数	f_T	$V_{CE} = 6\text{V}, I_E = -2\text{mA}$	1 1 2			MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 6\text{V}, I_E = 0, f = 1\text{MHz}$			7.0	pF
$C_{c,rb}$	$C_{c,rb}$	$V_{CE} = 6\text{V}, I_E = -2\text{mA}, f = 318\text{MHz}$			600	pS

規格細分 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

ラン ク	$h_{FE1} (I_C = 1\text{mA}, V_{CE} = 3\text{V})$	
	最 小 値	最 大 値
5	8 7	1 6 7
6	1 3 7	2 6 4
7	2 1 6	4 2 2
8	3 4 6	6 6 0

マ ー ク 標 示

品 名



2SC633SP → 7, 8
2SC634SP → 5, 6, 7, 8